



桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GM6411

SCHOTTKY DIODE 肖特基二極管

■FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^{\circ}\text{C})$	225	mW
Forward Current 正向電流	I_F	500	mA
Reverse Voltage 反向電壓	V_R	20	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	T_J, T_{stg}	125°C, -40to+150°C	

■DEVICE MARKING 打標

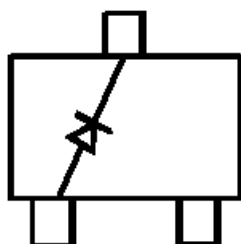
GM6411=D2E

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ($I_R=600\mu\text{A}$)	$V_{(BR)}$	20	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 ($V_R=20\text{V}$)	I_R	—	50	μA
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=10\text{mA}_{dc}$ $I_F=50\text{mA}_{dc}$ $I_F=100\text{mA}_{dc}$ $I_F=500\text{mA}_{dc}$	V_F		230 280 320 480	mV
Diode Capacitance 二極體電容 ($V_R=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}$)	C_D	—	20	pF

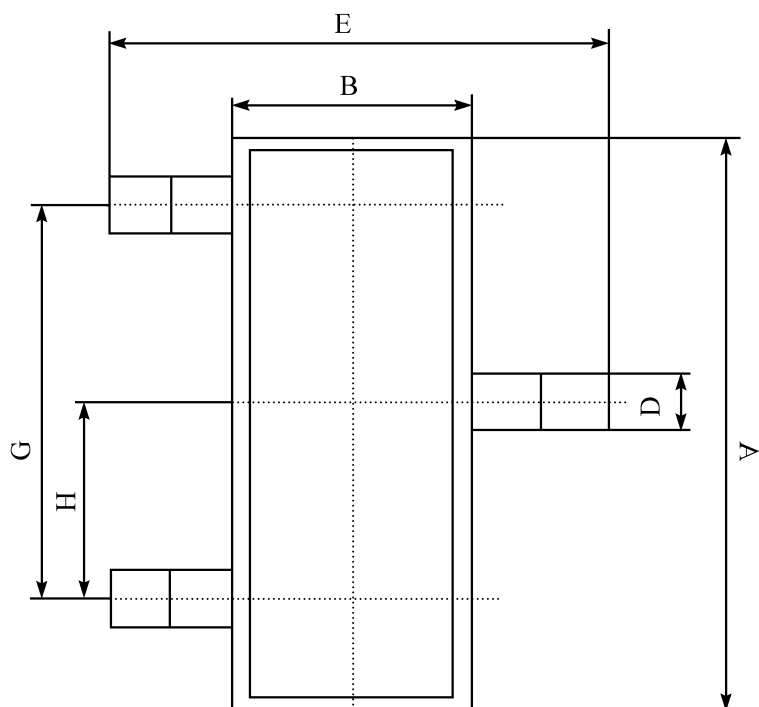
■SOT-23 内部结构





GM6411

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
B	1.30 ± 0.10
C	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
E	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
H	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	$0.00-0.10$
M	≥ 0.2
N	0.60 ± 0.10
P	$7 \pm 2^\circ$

